



650V CoolSiC[®] MOSFET von Infineon in TOLL (PG-HSOF-8) und D2PAK (TO-263) Gehäusen

2021-06-16 – online

In Zeiten rasanter Weiterentwicklung ist kontinuierliches Lernen essenziell, um auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben. Mit diesem Seminar bietet Arrow Ihnen eine Weiterbildungsmöglichkeit an.

Silizium-Carbid MOSFETs bieten im Vergleich zu Standard Silizium MOSFETs viele Vorteile, und können daher genutzt werden, um in vielen Applikationen Verbesserungen zu erreichen. Im Vordergrund stehen hier höhere Schaltfrequenzen, aber auch neue Topologien wie z.B. eine Totem-Pole PFC. Damit ermöglichen SiC MOSFETs effizientere Schaltungen aber auch kleinere Geräte-Bauformen. Um diese Vorteile auch mechanisch optimal nutzen zu können ist es notwendig von den klassischen Gehäuseformen wie z.B. TO-247 auf neuere und den Anforderungen besser angepasste Alternativen zu wechseln. Hier bieten das neue TOLL und das D2PAK die besten Eigenschaften für die Positionierung der Leistungsschalter und die Optimierung des Platzbedarfs. Es werden sowohl die Eigenschaften der neuen Gehäuse als auch anhand einer Totem-Pole PFC die Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt.

Sprecher: Harun Duyan (Regional Marketing Manager, Infineon)
Sprache: Deutsch
Voraussetzungen: keine
Seminaraktivitäten: Präsentation
Ansprechpartner: Claudia Colombini, claudia.colombini@arrow.com , +49 151 16717000

Agenda (Zeitzone: MESZ)

14:00 – 14:05	Begrüßung und Vorstellung
14:05 – 14:35	650V CoolSiC [®] MOSFET von Infineon in TOLL (PG-HSOF-8) and D2PAK (TO-263) Packages
14:45 – 15:00	Fragen und Antworten

[Register](#)